

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成29年1月12日(2017.1.12)

【公開番号】特開2015-119164(P2015-119164A)

【公開日】平成27年6月25日(2015.6.25)

【年通号数】公開・登録公報2015-041

【出願番号】特願2014-163839(P2014-163839)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 4 7 Z

H 01 L 21/304 6 4 8 G

H 01 L 21/304 6 4 3 A

【手続補正書】

【提出日】平成28年11月17日(2016.11.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 1 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 1 1】

ここで、第2の実施形態に係る基板洗浄装置14Aのように、アルカリ現像液の濃度を変化させる場合には、第1液供給部40Bが備えるノズル41aからDIWを供給しながら、第2液供給部40Cが備えるノズル41bからアルカリ現像液を供給すればよい。かかる場合、ウェハW上でアルカリ現像液とDIWとが混合され、ウェハW上で低濃度のアルカリ現像液が生成される。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 1 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 1 5】

ここで、図10に示すグラフの横軸は、ペアシリコンウェハ上の位置(ウェハ径)を示しており、直径300mmのペアシリコンウェハの中心位置を0とし、両端位置をそれぞれ-150, 150としている。また、図10に示すグラフの縦軸は、トップコート膜の膜厚を示しており、その値は、トップコート膜を形成した後の膜厚に対する各膜厚の比率を示している。図10では、トップコート膜を形成する前の膜厚を実線L1で、トップコート膜を形成した後の膜厚を破線L2で、常温の純水を供給した後の膜厚を一点鎖線L3でそれぞれ示している。ここで、常温の純水(以下、「CDIW」と記載する)とは、例えば23の純水のことをいう。

【手続補正3】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図13

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 13】

